



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ Patentschrift
⑩ DE 100 32 624 C 2

⑤1 Int. Cl.7:
F 16 C 33/12
C 22 C 12/00

②1 Aktenzeichen: 100 32 624.2-24
②2 Anmeldetag: 7. 7. 2000
④3 Offenlegungstag: 26. 4. 2001
④5 Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: 21. 8. 2003

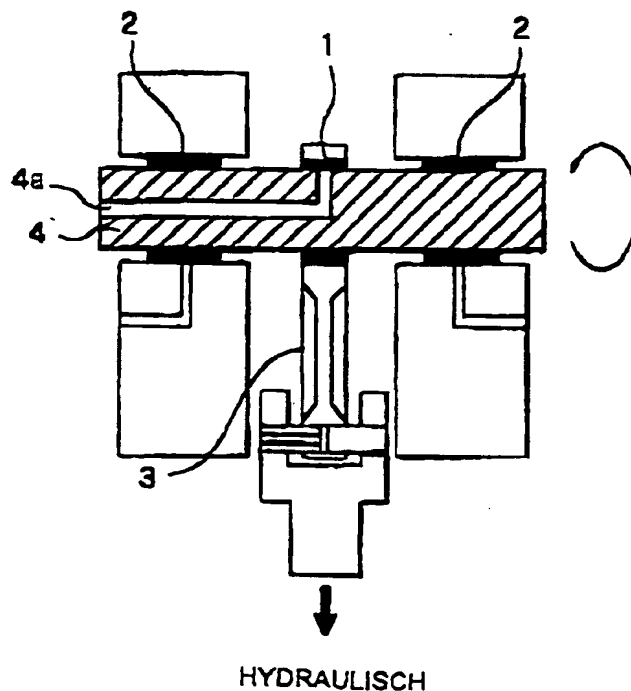
Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

- ③0 Unionspriorität:
11-193970 08. 07. 1999 JP
- ⑦3 Patentinhaber:
Taiho Kogyo Co., Ltd., Toyota, Aichi, JP; Toyota
Jidosha K.K., Toyota, Aichi, JP; Kabushiki Kaisha
Toyota Chuo Kenkyusho, Aichi, JP
- ⑦4 Vertreter:
COHAUSZ & FLORACK, 40472 Düsseldorf

- ⑦2 Erfinder:
Tomikawa, Takashi, Toyota, Aichi, JP; Michioka,
Hirofumi, Toyota, Aichi, JP; Fuwa, Yoshio, Toyota,
Aichi, JP; Shimura, Yoshio, Nagakute, Aichi, JP;
Hotta, Shigeru, Nagakute, Aichi, JP
- ⑤6 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:
DE 30 00 279 C2
US 50 39 576
EP 07 95 693 A2
JP 08020893 A (abstract) In: Patent Abstracts of
Japan [CD-ROM];

⑤4 Gleitlager und sein Herstellungsverfahren

- ⑤7 Gleitlager, welches ein Lagermetall und eine auf dem
Lagermetall ausgebildete Laufschrift aus Bismut oder
Bismut-Legierung umfaßt, wobei das unten definierte
relative Verhältnis der Röntgenstrahlbeugungsstärke $I_{\{hkl\}}$
der Laufschrift aus Bismut oder Bismutlegierung die fol-
genden Bedingungen (a) und (b) erfüllt:
(a) das relative Verhältnis der Röntgenstrahlbeugungs-
stärke $I_{\{hkl\}}$ von anderen Ebenen als {012} ist 0,2- bis 5mal
so hoch wie das Verhältnis der Röntgenstrahlbeugungs-
stärke $I_{\{012\}}$, das heißt, $0,2I_{\{012\}} \leq I_{\{hkl\}} \leq 5I_{\{012\}}$;
(b) das relative Verhältnis der Röntgenstrahlbeugungs-
stärke $I_{\{hkl\}}$ von drei oder mehr anderen Ebenen als {012}
fällt in einen Bereich, der 0,5- bis 2mal so hoch ist wie das
relative Verhältnis der Röntgenstrahlbeugungsstärke
 $I_{\{012\}}$, das heißt, $0,5I_{\{012\}} \leq I_{\{hkl\}} \leq 2I_{\{012\}}$,
wobei die {hkl}-Ebenen von Bismutkristallen von Stan-
dardpulverproben, welche Zufallsorientierung aufweisen,
die Röntgenstrahlbeugungsstärke $R_p(hkl)$ anzeigen; die
{hkl}-Ebenen von Bismutkristallen der Laufschrift aus
Bismut oder Bismutlegierung die Röntgenstrahlbeu-
gungsstärke $R_{O/L}(hkl)$ anzeigen; das Verhältnis der beiden
Stärken durch $K(hkl) = R_{O/L}(hkl)/R_p(hkl)$ ausgedrückt wird;
das Verhältnis von $K(012)$ und $K(hkl)$ durch $I(hkl) =$
 $K(hkl)/K(012)$ ausgedrückt wird.



DE 100 32 624 C 2

Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gleitlager, insbesondere ein Gleitlager, welches umfaßt: eine Lagerlegierungsschicht, welche als Lagermetall bezeichnet wird und aus einer Kupfer/Blei-Legierung oder einer Aluminiumlegierung besteht; und eine Laufschrift, welche aus einer Weichlegierungs-Plattierungsschicht besteht und auf das Lagermetall aufgetragen wird, um diesem Kompatibilität zu verleihen; und eine Ni-Plattierungs-Sperrschicht und dergleichen, welche in manchen Fällen zwischen dem Lagermetall und der Laufschrift ausgebildet ist. Die vorliegende Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum Herstellen des Gleitlagers.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Das oben beschriebene Gleitlager wird in erster Linie für den Zapfenabschnitt einer Kurbelwelle oder das große Ende einer Pleuelstange eines Verbrennungsmotors verwendet. Als Laufschrift werden in erster Linie Bleilegierungen und mitunter Zinnlegierungen verwendet.

[0003] Einem der Anmelder der vorliegenden Anmeldung ist es gelungen, die Zusammensetzung der Laufschrift-Bleilegierung gemäß dem Deutschen Patent Nr. DE 30 00 279 C2 zu verbessern und die Kristallorientierung gemäß der Ungeprüften Japanischen Patentschrift (Kokai) Nr. JP 08020893 A zu verbessern.

[0004] Da Blei ein umweltbelastender Schadstoff ist, ist die Einstellung seiner Verwendung oder die Verringerung der verwendeten Mengen erforderlich. Eine Entwicklung zum Vermeiden der Verwendung von Blei als Laufschrift geht in die Richtung des Bondens eines tribologischen Werkstoffes wie MoS_2 mit Harz, um die Laufschriftfolie zu bilden. Darüber hinaus hat einer der Anmelder der vorliegenden Anmeldung in der Europäischen Patentveröffentlichung Nr. EP 0795693 A2 eine Cu-Ag-Legierung vorgeschlagen, welche eventuell keine Laufschrift erfordert.

[0005] Übrigens ist Bismut wie Blei ein Metall mit einem niedrigen Schmelzpunkt. Bismut ist härter und spröder als Blei. Im Detail ist die Härte $\text{Hv}_{0,2}$ von Blei 5, während die Härte $\text{Hv}_{0,2}$ von Bismut 10 ist. Elektroplattieren, welches häufig zum Herstellen einer Laufschrift verwendet wird, härtet die entstehende Schicht infolge der Absorption von Wasserstoff. Das heißt, die Härte $\text{Hv}_{0,2}$ von elektroplattiertem Blei beträgt 10, während die Härte $\text{Hv}_{0,2}$ von herkömmlich elektroplattiertem Bismut ungefähr 20 beträgt. Eine derartige Eigenschaft von Bismut ist nicht geeignet, um Ermüdungsfestigkeit und Kompatibilität des Gleitmaterials zu erreichen. Demzufolge wurde Bismut nicht als Gleitmaterial verwendet.

[0006] Aus der US 5,039,576 ist ein Verfahren zum galvanischen Beschichten eines Leitersubstrates mit einer Zinn/Bismut-Legierung bekannt. Dort ist bereits beschrieben worden, dass Bismut katodisch aus einer Elektrolytlösung, die eine Alcylsulfonsäure, insbesondere eine Methansulfonsäure, und ein Bismutalcylsulfonat enthält, abgeschieden werden kann.

[0007] Mittlerweile wird der niedrige Schmelzpunkt von Bismut in der Lötlegierung auf Bismutbasis oder dem Formkern auf Bismutbasis genutzt. Bismut wird auch als Halbleiterwerkstoff, elektronischer Werkstoff, optische Speichermedien (siehe beispielsweise Ungeprüfte Japanische Patentschrift Nr. 4-51742) und Magnetwerkstoff (Mn-Bi-Magnet) verwendet. Dieses Speichermedium wird durch Zerstäuben hergestellt.

[0008] Die gegenständlichen Erfinder haben ausführliche Forschungsarbeiten hinsichtlich des Ersetzens von Blei durch Bismut betrieben, in dem Bestreben, die verglichen mit Blei bessere Korrosionsbeständigkeit von Bismut in saurer Lösung zu nutzen und die Toxizität von Blei zu vermeiden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0009] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Bismutwerkstoff zu entdecken, welcher die Ermüdungsfestigkeit und Kompatibilität, die für eine Laufschrift erforderlich sind, aufweist, und ein verbessertes Gleitlager vorzusehen.

[0010] Es ist ebenfalls eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum Herstellen eines Gleitlagers vorzusehen, welches eine Laufschrift aus Bismut oder Bismutlegierung umfaßt, deren Kristalle derart orientiert sind, daß Ermüdungsfestigkeit und Kompatibilität verglichen mit den im wesentlichen zufallsorientierten Bismutkristallen oder im wesentlichen oder zur Gänze einkristallinen Bismutkristallen erheblich verbessert sind.

[0011] Die vorliegende Erfindung umfaßt eine Entdeckung, daß Härte und Sprödigkeit von Bismut durch Steuern der Orientierung von Bismutkristallen bis auf ein derartiges Maß verbessert werden können, so, daß diese kein ernsthaftes Problem darstellen.

[0012] Das von der vorliegenden Erfindung vorgeschlagene Gleitlager umfaßt ein Lagermetall und eine aus Bismut oder Bismutlegierung gebildete Laufschrift, welche auf dem Lagermetall mit oder ohne dazwischenliegender Sperrschicht ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, daß das unten definierte relative Verhältnis der Röntgenstrahlbeugungsstärke $I_{\{hkl\}}$ die folgenden Bedingungen (a) und (b) erfüllt:

(a) Das relative Verhältnis der Röntgenstrahlbeugungsstärke $I_{\{hkl\}}$ von anderen Ebenen als {012} ist 0,2- bis 5mal so hoch wie das Verhältnis der Röntgenstrahlbeugungsstärke $I_{\{012\}}$, das heißt, $0,2I_{\{012\}} \leq I_{\{hkl\}} \leq 5I_{\{012\}}$;

(b) Das relative Verhältnis der Röntgenstrahlbeugungsstärke $I_{\{hkl\}}$ von drei oder mehr anderen Ebenen als {012} fällt in einen Bereich, der 0,5- bis 2mal so hoch ist wie das relative Verhältnis der Röntgenstrahlbeugungsstärke $I_{\{012\}}$, das heißt, $0,5I_{\{012\}} \leq I_{\{hkl\}} \leq 2I_{\{012\}}$.

[0013] Die Definition des relativen Verhältnisses der Röntgenstrahlbeugungsstärke $I_{\{hkl\}}$ lautet wie folgt: Die $\{hkl\}$ -Ebenen von Bismutkristallen von Standardpulverproben, welche eine Zufallsorientierung aufweisen, zeigen die Röntgenstrahlbeugungsstärke $R_p(hkl)$ an; die $\{hkl\}$ -Ebenen von Bismutkristallen der Laufschrift aus Bismut oder Bismutlegierung zeigen die Röntgenstrahlbeugungsstärke $R_{OL}(hkl)$ an; das Verhältnis beider Stärken wird durch $K(hkl) = R_{OL}(hkl)/R_p(hkl)$ ausgedrückt; das Verhältnis $K(012)$, das heißt $K(hkl)$ der $\{012\}$ -Ebene und $K(hkl)$ der Röntgenstrahlbeugungsstärke an der $\{hkl\}$ -Ebene, werden in das Verhältnis der Röntgenstrahlbeugungsstärke $I_{\{hkl\}} = K(hkl)/K(012)$ umgerechnet. 5

[0014] Das Verfahren zum Herstellen eines Gleitlagers gemäß der vorliegenden Erfindung umfaßt die Schritte des: Anfertigen eines Trägermetalls in Form eines Streifens;

Anfertigen eines Lagermetalls in Form eines Streifens, bestehend aus einem Werkstoff, welcher aus der Gruppe, umfassend eine Aluminiumlagerlegierung und eine Kupferlagerlegierung, ausgewählt wird; 10

Bringen des Lagermetalls in Kontakt mit einer elektrolytischen Lösung, welche Methansulfonsäure und Bismutmethansulfonat enthält; und

kathodisches Auftragen von Bismut auf dem Lagermetall.

[0015] Eine andere elektrolytische Lösung kann Schwefelsäure und Bismutsulfat enthalten. 15

[0016] In einem Aspekt der vorliegenden Erfindung wird die Verwendung von Bismut oder Bismutlegierung, welche die oben genannten Bedingungen (a) und (b) erfüllen, für eine Laufschrift eines Gleitlagers vorgesehen.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0017] Die vorliegende Erfindung wird in der Folge ausführlich beschrieben. Bismut ist ein rhomboedrischer Kristall, der einem hexagonalen Kristall gleichwertig ist. Im allgemeinen wird der Millersche Index des hexagonalen Kristalls durch vier Parameter (h, k, i, l) zum Ausdruck gebracht. Hier zeigen h, k bzw. i die $a_{1,2,3}$ -Achsen an. Das Zeichen "l" bezeichnet den Index der c-Achse. Da im Bi-Kristall die Beziehung $h + k = -i$ feststeht, wird der Parameter i weggelassen, und die drei Parameter (hkl) werden verwendet, um die Gitterebenen eines Bismutkristalls zu definieren. 25

[0018] Die Schicht aus Bi oder Bi-Legierung wird, abgesehen von der Beschreibung ihrer Zusammensetzung, allgemein als "Bi-Schicht" bezeichnet. Die Bi-Schicht weist eine Zwischenorientierung zwischen der völlig zufälligen, wie jener des feinen Pulvers, und einer bestimmten Orientierung, wie jener des Einzelkristalls, auf.

[0019] Die Orientierung wird folgendermaßen beurteilt.

[0020] Zunächst werden die Bi-Kristalle, welche eine völlig zufällige Orientierung aufweisen, wie etwa das Pulver, Röntgenstrahlbeugung unterzogen. Die sich ergebende Beugungsstärke der jeweiligen Ebenen ist $R_p(hkl)$. Ebenso werden die Bi-Kristalle einer Laufschrift der Röntgenstrahlbeugung unterzogen. Die sich ergebende Beugungsstärke der jeweiligen Ebenen ist $R_{OL}(hkl)$. Daraufhin wird deren Verhältnis $K(hkl) = R_{OL}(hkl)/R_p(hkl)$ berechnet. Im Fall von $K(hkl) > 1$ ergibt sich, daß die Bi-Kristalle einer Laufschrift in (hkl) orientiert sind. 30

[0021] Es ist zu beachten, daß es zwei $K(hkl)$ der Bi-Kristalle gibt, d. h. $K(hkl)$ von $\{012\}$ und $K(hkl)$ der anderen Ebenen als $\{012\}$. Ihre relative Größe wird als Verhältnis $I_{\{hkl\}} = K(hkl)/K(012)$ berechnet. Wenn $I_{\{hkl\}} = 0$, so ergibt sich, daß ein $\{012\}$ -Einzelkristall gebildet wird. Wenn andererseits $I_{\{hkl\}} > 1$, so ergibt sich, daß die (hkl)-Kristalle stark orientiert sind. Wenn $K(012) = 1$ und $K(hkl) = 1$, so sind die Bi-Kristalle zufällig oder zur Gänze nicht orientiert. Diesfalls beträgt $I_{\{hkl\}}$ für jede (hkl)-Ebene 1. Im Gegensatz dazu sind, selbst wenn $I_{\{hkl\}}$ für mehrere (hkl)-Ebenen 1 beträgt, jedoch mehrere andere Ebenen eine $I_{\{hkl\}}$ aufweisen, die ungleich 1 ist, die Kristalle nicht zur Gänze zufallsorientiert, sondern in einer bestimmten Orientierung ausgerichtet. Weder der $\{012\}$ -Einzelkristall, welcher $I_{\{hkl\}} = 0$ aufweist, noch die völlig zufällig orientierten Kristalle, welche eine $I_{\{hkl\}} = 1$ aufweisen, zeigen als Laufschrift verbesserte Eigenschaften. Diese Kristalle sowie die im wesentlichen einkristallinen und die im wesentlichen zufallsorientierten Kristalle sind daher von der vorliegenden Erfindung ausgeschlossen. Die starke Orientierung gemäß einer bestimmten Kristallebene ist ebenfalls ausgeschlossen, wie in der Folge erläutert wird. 40 45

[0022] Bei den Bedingungen (a) und (b) unter Zuhilfenahme von $I_{\{hkl\}}$, werden $I_{\{hkl\}}$ und $K_{\{012\}}$ miteinander verglichen. Wenn im Gegensatz dazu beispielsweise eine Bedingung aufgestellt wird, derart, daß $K(hkl) \geq n$ ist, das heißt, daß die Orientierung nur durch $K(hkl)$ beurteilt wird, dann wird es schwierig, den Grad der Orientierung der nicht- $\{012\}$ -Ebenen relativ zu den $\{012\}$ -Ebenen zu regeln und somit die tribologischen Eigenschaften zu regeln. Die Bedingung (a), das heißt $0,2I_{\{012\}} \leq I_{\{hkl\}} \leq 5I_{\{012\}}$, umfaßt ein Konzept, daß die $\{012\}$ -Ebenen als Norm verwendet werden und der relative Orientierungsgrad innerhalb eines bestimmten Bereichs geregelt wird. Andererseits sind, wenn $I_{\{hkl\}} > 5I_{\{012\}}$, die nicht- $\{012\}$ -Ebenen so stark orientiert, daß die Laufschrifteigenschaften nicht verbessert sind. Wenn $I_{\{hkl\}} < 0,2I_{\{012\}}$, ist die Orientierung von $\{012\}$ -Ebenen so stark, daß die Laufschrifteigenschaften ebenfalls nicht verbessert sind. Vorzugsweise ist $0,5I_{\{012\}} \leq I_{\{hkl\}} \leq 2I_{\{012\}}$. 50

[0023] Zusätzlich zu Bedingung (a) wird Bedingung (b) aufgestellt, daß heißt, daß drei oder mehr Ebenen eine bevorzugte Orientierung aufweisen, die nicht kleiner als 0,5mal und nicht mehr als das Doppelte von $I_{\{012\}}$ beträgt. Drei oder mehr Ebenen ausgenommen $\{012\}$, können bevorzugt orientiert sein, vorausgesetzt, daß der Grad ihrer Orientierung auf innerhalb eines nicht übermäßigen Bereichs beschränkt ist, wie in Bedingung (b) vorgegeben wird. Die Bedingungen (a) und (b) sind demnach das Kriterium, welches die Sprödigkeit oder Verformbarkeit von Bismut bestimmt. 55

[0024] Es ist möglich, die Sprödigkeit und Härte der Bi-Kristallschicht durch Regeln der Beugungsstärke der drei Ebenen, d. h. der $\{104\}$ -, der $\{110\}$ - und der $\{202\}$ -Ebene, der Bi-Kristallschicht beinahe vollständig zu regeln. Auch durch Einstellen der Elektroplattierungsbedingungen kann diese Beugungsstärke geregelt werden. Hier können zusätzlich zur $\{012\}$ -Ebene, da die $\{104\}$ -, die $\{110\}$ - und die $\{202\}$ -Ebene eine größere Röntgenbeugungsstärke als die anderen Ebenen aufweisen, die oben genannten Bedingungen (a) und (b) durch Einstellen der Beugungsstärke dieser drei Ebenen und somit von $I_{\{hkl\}}$ von $\{104\}$, $\{110\}$ und $\{202\}$ erfüllt werden. Die gewünschten Eigenschaften können in nahezu allen Fällen erreicht werden, indem die Röntgenbeugungsstärke den oben genannten drei Ebenen kontrolliert wird. Die gewünschten Eigenschaften können mit größerer Gewißheit erreicht werden, wenn auch $\{015\}$, $\{113\}$, $\{116\}$, $\{107\}$, $\{122\}$, $\{214\}$ und $\{300\}$ die oben genannten Beziehungen (a) und (b) erfüllen. 60 65

[0025] Die Kristallkörner einer Bi-Plattierung sind vorzugsweise 10 µm groß oder kleiner, insbesondere 5 µm oder kleiner. Wenn die Korngröße 10 µm übersteigt, wird die Ermüdungsfestigkeit ernsthaft beeinträchtigt, bis auf ein niedrigeres Niveau als jenes, welches für eine Laufschrift erforderlich ist. Die Laufschrift ist vorzugsweise 2 bis 20 µm dick, insbesondere 5 bis 12 µm.

[0026] Bei der vorliegenden Erfindung kann die Laufschrift aus einer Bi-Legierung bestehen, bei der 5 Gew.-% oder weniger aus der Gesamtmenge aus Sn, In, Sb und dergleichen bestehen kann. Diese Elemente sind als Zusatzelemente einer Pb-Laufschrift bekannt. Diese Elemente tragen zu einer Verstärkung der Kompatibilität und der Ermüdungsfestigkeit in der auf Bi basierenden Legierung bei. Wenn allerdings die Menge dieser Elemente 5 Gew.-% übersteigt, wird der Schmelzpunkt der Laufschrift soweit gesenkt, daß die Eigenschaften der Laufschrift beeinträchtigt.

[0027] Die auf Cu oder Al basierenden Gleitlagerlegierungen und die Ni-Sperrschicht sind an sich bekannt. Bei der vorliegenden Erfindung können breitgefächerte Variationen derartiger Legierungen und der Ni-Sperrschicht verwendet werden, und die Erfindung wird durch derartige Legierungen und die Ni-Sperrschicht überhaupt nicht eingeschränkt.

[0028] Beim Verfahren zum Herstellen des Gleitlagers gemäß der vorliegenden Erfindung sind die Schritte des Druckbondens der Trägerschicht mit dem Lagermetall bekannt. Das erfindungsgemäße Verfahren ist durch ein Elektroplattierverfahren gekennzeichnet, welches zur oben beschriebenen Orientierung der Kristallkörner führt.

[0029] Vorzugsweise werden die folgenden Elektroplattierbäder verwendet, um die oben beschriebene Orientierung zu regeln.

(1) Methansulfonsäurebad A

Zusammensetzung des Bades: 50 bis 250 ml/l
Methansulfonsäure und 50 bis 250 ml/l
Bismutmethansulfonat und 0,5 bis 50 g/l β-Naphtol
Badtemperatur: 25°C
Stromdichte: 0,5–5,0 A/dm²

(2) Methansulfonsäurebad B

Zusammensetzung des Bades: 50 bis 200 ml/l
Methansulfonsäure und 50 bis 250 ml/l
Bismutmethansulfonat und 0,5 bis 50 g/l Polyoxyethylen-Nonylphenylether
Badtemperatur: 25°C
Stromdichte: 0,5–5,0 A/dm²

(3) Schwefelsäurebad

Zusammensetzung des Bades: 50 bis 120 ml/l Schwefelsäure und 5 bis 30 g/l Bismutnitrat und 0,5 bis 50 g/l Polyoxyethylen-Nonylphenylether
Badtemperatur: 25°C
Stromdichte: 0,5–5,0 A/dm²

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0030] Fig. 1 ist eine schematische Ansicht eines hin- und hergehenden Prüfgeräts für dynamische Last,

[0031] Fig. 2 ist ein Schaubild, welches ein Prüfmuster des hin- und hergehenden Prüfgeräts für dynamische Last darstellt,

[0032] Fig. 3 ist ein Foto, welches die Oberflächenplattierungsstruktur von Beispiel 1 zeigt,

[0033] Fig. 4 ist das Röntgenbeugungsdiagramm der in Beispiel 1 gebildeten Plattierungsschicht,

[0034] Fig. 5 ist ein Foto, welches die Oberflächenplattierungsstruktur von Vergleichsbeispiel 4 zeigt,

[0035] Fig. 6 ist das Röntgenbeugungsdiagramm der in Vergleichsbeispiel 4 gebildeten Plattierungsschicht,

[0036] Fig. 7 ist ein Foto, welches die Oberflächenplattierungsstruktur von Vergleichsbeispiel 6 zeigt,

[0037] Fig. 8 ist ein Schaubild, welches den Quotienten der vorkommenden Ermüdung bei den Beispielen und den Vergleichsbeispiele darstellt.

BEISPIELE

[0038] Die vorliegende Erfindung wird in der Folge durch Bezugnahme auf die Beispiele und die Vergleichsbeispiele beschrieben.

[0039] Die Gleitlager, welche in den folgenden Beispielen und Vergleichsbeispielen hergestellt wurden, wiesen die folgende Struktur auf.

Trägermetall: Stahlblech (SPCC, Dicke: 1 mm)

Gleitlagerlegierung: Cu-Sn-Ag-Legierung (Europäische Patentschrift 0795693 A1)

Ni-Sperrschicht: nicht verwendet

Laufschrift: 6 µm dickes, reines Bi.

[0040] Die Prüfbedingungen waren wie folgt:

Prüfgerät: hin- und hergehendes Prüfgerät für dynamische Belastung (vgl. Fig. 1)

Gleitgeschwindigkeit: 6,6 m/Sekunde (3000 U/min, vgl. Fig. 2)

spezifische Lagerbelastung: schrittweise Lastzunahme (vgl. Fig. 2)

Lagerabmessungen: 42 mm Durchmesser und 17 mm Breite

Material der Welle: S55C (gehärtet)

Art des Schmieröls: 7,5W-30SE

Temperatur des zugeführten Öls: 120°C

Prüfzeitraum: 25 h.

[0041] Bezugnehmend auf Fig. 1 wird dort ein hin- und hergehendes Prüfgerät für dynamische Belastung dargestellt. Die Bezugszeichen benennen die folgenden Teile: 1 – geprüfetes Lager; 2 – Haltelager einer Welle; 3 – Pleuelstange; 4 – Welle, d. h. die Gegenwelle; und 4a – Ölzufuhröffnung. Das angebrachte Lager 1 befindet sich in lokalem Kontakt mit der Welle 4. Diese Prüfung führt zu derartigen Ergebnissen, daß: wenn die ursprüngliche Kompatibilität der Laufschrift schlecht ist, es zu Ermüdung kommt; und daß, selbst wenn die ursprüngliche Kompatibilität der Laufschrift gut ist, es leicht zu einem Festfressen kommt, wenn die Materialeigenschaften der Laufschrift schlecht sind.

[0042] Die Bi-Plattierschicht der Beispiele 1 bis 3 und der Vergleichsbeispiele 4 bis 6 sowie das Bi-Pulver wurden der Röntgenbeugung (Cu-K α -Strahl) unterzogen. Die resultierende $I_{[hkl]}$ wird in Tabelle 1 angeführt. Die in Tabelle 1 angeführte Beugungsstärke von (024) ist jene, welche in bezug auf (012) relativ ist. Da (024) und (012) kristallografisch gleichwertig sind, sollte $I_{[024]}$ gleich $I_{[012]}$ sein. Da allerdings die Beugungsstärke des höheren Millerschen Index infolge des Einflusses der Penetrationstiefe von Röntgenstrahlen und dergleichen niedriger zu sein pflegt, $I_{[024]} \leq I_{[012]}$. Diese Tatsachen sollten beim Evaluieren der Ergebnisse aus Tabelle 1 in Betracht gezogen werden. Die folgenden Auswertungen können durchgeführt werden:

- (i) Weder die Beispiele noch die Vergleichsbeispiele sind gänzlich zufallsorientiert oder einkristallig.
- (ii) Bei Vergleichsbeispiel 5 ist die (104)-Ebene stark orientiert, was $I_{[104]} = 5,22$ ergibt. Eine derart starke Orientierung wird bei Beispiel 1 bis 3 nicht beobachtet.
- (iii) Bei Vergleichsbeispiel 4 sind, da $I_{[104]}$, $I_{[113]}$, $I_{[202]}$, $I_{[116]}$, $I_{[122]}$ und $I_{[214]}$ extrem klein sind, die {012}-Ebenen relativ stark orientiert. Bei Vergleichsbeispiel 5 sind $I_{[104]}$ und $I_{[300]}$ über 5, das heißt, mehr als das Fünffache von $I_{[012]}$. Die Beugungsstärke der anderen Ebenen ist niedrig. Die Plattierungsschicht aus Vergleichsbeispiel 5 ist daher in den beiden bevorzugten Orientierungen, {104} und {300}, ausgerichtet.
- (iv) Die Beispiele 1 bis 3 erfüllen die oben genannten Bedingungen (a) und (b). Das heißt, daß, da keine überaus starke Ausrichtung in den bestimmten Orientierungen vorliegt, die Bedingung (a) erfüllt wird. Die unter Bedingung (b) vorgegebene Anzahl an bevorzugt orientierten Ebenen beträgt drei oder mehr und ist somit geeignet. Die bevorzugte Orientierung ist daher nicht auf einige wenige bestimmte Ebenen beschränkt. Übrigens ist die Stärke der (012)-Ebene unter den {012}-Ebenen auf Eins gesetzt. Auch wenn die Stärke der gleichwertigen (024)-Ebene auf Eins gesetzt ist und als Berechnungsgrundlage verwendet wird, erhält man dieselben Ergebnisse.

[0043] Die Plattierungsoberflächenstruktur aus Beispiel 1 wird in Fig. 3 dargestellt. Das Röntgenstrahlbeugungsdiagramm von Beispiel 1 wird in Fig. 4 dargestellt. Dieses wird danach unter Verwendung der Pulverstärke als Kriterium konvertiert. Die Plattierungsoberflächenstruktur von Vergleichsbeispiel 4 wird in Fig. 5 dargestellt. Das Röntgenstrahlbeugungsdiagramm von Vergleichsbeispiel 4 wird in Fig. 6 dargestellt. Dieses wird daraufhin unter Verwendung der Pulverstärke als Kriterium konvertiert. Die Plattierungsoberflächenstruktur von Vergleichsbeispiel 6 wird in Fig. 7 dargestellt. Der Durchmesser von Kristallen der Plattierschicht beträgt 2,8 μm in Beispiel 1, 5,8 μm in Vergleichsbeispiel 4 und 10,6 μm in Vergleichsbeispiel 6.

[0044] Die Ergebnisse der Prüfung werden in Tabelle 1 und Fig. 8 dargestellt. Die Daten "Vergleichsbeispiel, Pb-Sn-In-Laufschrift", welche in Fig. 8 dargestellt werden, entsprechen der herkömmlichen Laufschrift auf Pb-Basis, welche 10% Sn und 10% In enthält. Diese Daten würden ein Kriterium für den Vergleich der Ermüdungshäufigkeit darstellen. Aus Fig. 9 ist zu ersehen, daß die Ermüdungs- und Festreißbeständigkeit der erfindungsgemäßen Beispiele 1 bis 3 jener der Vergleichsbeispiele 4 bis 6 überlegen und jener der herkömmlichen Laufschrift auf Pb-Basis ebenbürtig ist.

Tabelle 1

	Orientierungsindex Millerscher Ebenen												Kristall- körner μm	auftretende Ermüdung %	Festfressen Oberflächen- druck MPa
	012	104	110	015	113	202	024	107	116	122	214	300			
Beispiel 1	1,00	0,42	0,84	0,71	0,57	0,65	0,83	0,33	0,45	0,56	0,23	0,67	2,8	25,4	100
2	1,00	0,75	1,25	2,05	0,63	1,01	0,86	1,34	0,82	0,42	0,54	0,48	9,8	26,1	100
3	1,00	0,82	2,25	4,64	0,54	0,90	0,92	1,01	0,78	0,21	0,64	0,33	4,7	30,2	100
Ver- gleichs- beispiel	1	1,00	0,10	0,22	0,45	0,11	0,97	0,83	0,07	0,07	0,15	0,64	5,8	48,1	70
2	1,00	5,22	0,59	2,18	0,21	0,15	1,01	1,06	0,23	0,12	0,64	9,74	2,7	43,2	60
3	1,00	0,22	0,28	0,33	0,36	0,33	0,86	0,67	0,23	0,29	0,41	0,23	10,6	34,8	50

[0045] Wie oben beschrieben wurde, könnte die herkömmliche Laufschrift auf Pb-Basis durch die erfindungsgemäße Laufschrift auf Bi-Basis ersetzt werden.

1. Gleitlager, welches ein Lagermetall und eine auf dem Lagermetall ausgebildete Laufschrift aus Bismut oder Bismut-Legierung umfaßt, wobei das unten definierte relative Verhältnis der Röntgenstrahlbeugungsstärke $I_{\{hkl\}}$ der Laufschrift aus Bismut oder Bismutlegierung die folgenden Bedingungen (a) und (b) erfüllt:
 - (a) das relative Verhältnis der Röntgenstrahlbeugungsstärke $I_{\{hkl\}}$ von anderen Ebenen als {012} ist 0,2- bis 5mal so hoch wie das Verhältnis der Röntgenstrahlbeugungsstärke $I_{\{012\}}$, das heißt, $0,2I_{\{012\}} \leq I_{\{hkl\}} \leq 5I_{\{012\}}$;
 - (b) das relative Verhältnis der Röntgenstrahlbeugungsstärke $I_{\{hkl\}}$ von drei oder mehr anderen Ebenen als {012} fällt in einen Bereich, der 0,5- bis 2mal so hoch ist wie das relative Verhältnis der Röntgenstrahlbeugungsstärke $I_{\{012\}}$, das heißt, $0,5I_{\{012\}} \leq I_{\{hkl\}} \leq 2I_{\{012\}}$,
 wobei die {hkl}-Ebenen von Bismutkristallen von Standardpulverproben, welche Zufallsorientierung aufweisen, die Röntgenstrahlbeugungsstärke $R_p(hkl)$ anzeigen; die {hkl}-Ebenen von Bismutkristallen der Laufschrift aus Bismut oder Bismutlegierung die Röntgenstrahlbeugungsstärke $R_{OL}(hkl)$ anzeigen; das Verhältnis der beiden Stärken durch $K(hkl) = R_{OL}(hkl)/R_p(hkl)$ ausgedrückt wird; das Verhältnis von $K(012)$ und $K(hkl)$ durch $I_{\{hkl\}} = K(hkl)/K(012)$ ausgedrückt wird.
2. Gleitlager nach Anspruch 1, des weiteren umfassend eine Sperrschicht, welche zwischen dem Lagermetall und der Laufschrift aus Bismut oder Bismutlegierung ausgebildet ist.
3. Gleitlager nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Ebenen, bei denen es sich nicht um {012} handelt, {104}, {110} und {202} sind.
4. Gleitlager nach Anspruch 3, wobei die Ebenen, bei denen es sich nicht um {012} handelt, zusätzlich {015}, {113}, {116}, {107}, {122}, {214} und {300} umfassen.
5. Gleitlager nach einem beliebigen der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Laufschrift aus Bismut oder Bismutlegierung eine elektroplattierte Schicht ist.
6. Gleitlager nach einem beliebigen der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Laufschrift von 2 bis 20 µm dick ist.
7. Verfahren zum Herstellen eines Gleitlagers, umfassend die folgenden Schritte:
 - Anfertigen eines Trägermetalls in Form eines Streifens;
 - Anfertigen eines Lagermetalls in Form eines Streifens, bestehend aus einem Werkstoff, welcher aus der Gruppe, umfassend eine Aluminiumlagerlegierung und eine Kupferlagerlegierung, ausgewählt wird;
 - Bringen des Lagermetalls in Kontakt mit einer elektrolytischen Lösung, welche Methansulfonsäure und Bismutmethansulfonat enthält; und
 - kathodisches Auftragen von Bismut auf dem Lagermetall.
8. Verfahren zum Herstellen eines Gleitlagers, umfassend die folgenden Schritte:
 - Anfertigen eines Trägermetalls in Form eines Streifens;
 - Anfertigen eines Lagermetalls in Form eines Streifens, bestehend aus einem Werkstoff, welcher aus der Gruppe, umfassend eine Aluminiumlagerlegierung und eine Kupferlagerlegierung, ausgewählt wird;
 - Bringen des Lagermetalls in Kontakt mit einer elektrolytischen Lösung, welche Schwefelsäure und Bismutsulfat enthält; und
 - kathodisches Auftragen von Bismut auf dem Lagermetall.
9. Verwendung von Bismut oder einer Bismutlegierung für die Laufschrift, welche auf dem Lagermetall eines Gleitlagers ausgebildet ist, welches in einem Verbrennungsmotor verwendet wird, wobei das unten definierte relative Verhältnis der Röntgenstrahlbeugungsstärke $I_{\{hkl\}}$ der Laufschrift aus Bismut oder Bismutlegierung die folgenden Bedingungen (a) und (b) erfüllt:
 - (a) das relative Verhältnis der Röntgenstrahlbeugungsstärke $I_{\{hkl\}}$ von anderen Ebenen als {012} ist 0,2- bis 5mal so hoch wie das Verhältnis der Röntgenstrahlbeugungsstärke $I_{\{012\}}$, das heißt, $0,2I_{\{012\}} \leq I_{\{hkl\}} \leq 5I_{\{012\}}$;
 - (b) das relative Verhältnis der Röntgenstrahlbeugungsstärke $I_{\{hkl\}}$ von drei oder mehr anderen Ebenen als {012} fällt in einen Bereich, der 0,5- bis 2mal so hoch ist wie das relative Verhältnis der Röntgenstrahlbeugungsstärke $I_{\{012\}}$, das heißt, $0,5I_{\{012\}} \leq I_{\{hkl\}} \leq 2I_{\{012\}}$,
 wobei die {hkl}-Ebenen von Bismutkristallen aus Standardpulverproben, welche Zufallsorientierung aufweisen, die Röntgenstrahlbeugungsstärke $R_p(hkl)$ anzeigen; die {hkl}-Ebenen von Bismutkristallen der Laufschrift aus Bismut oder Bismutlegierung die Röntgenstrahlbeugungsstärke $R_{OL}(hkl)$ anzeigen; das Verhältnis der beiden Stärken durch $K(hkl) = R_{OL}(hkl)/R_p(hkl)$ ausgedrückt wird; das Verhältnis von $K(012)$ und $K(hkl)$ durch $I_{\{hkl\}} = K(hkl)/K(012)$ ausgedrückt wird.

Hierzu 7 Seite(n) Zeichnungen

Fig. 1

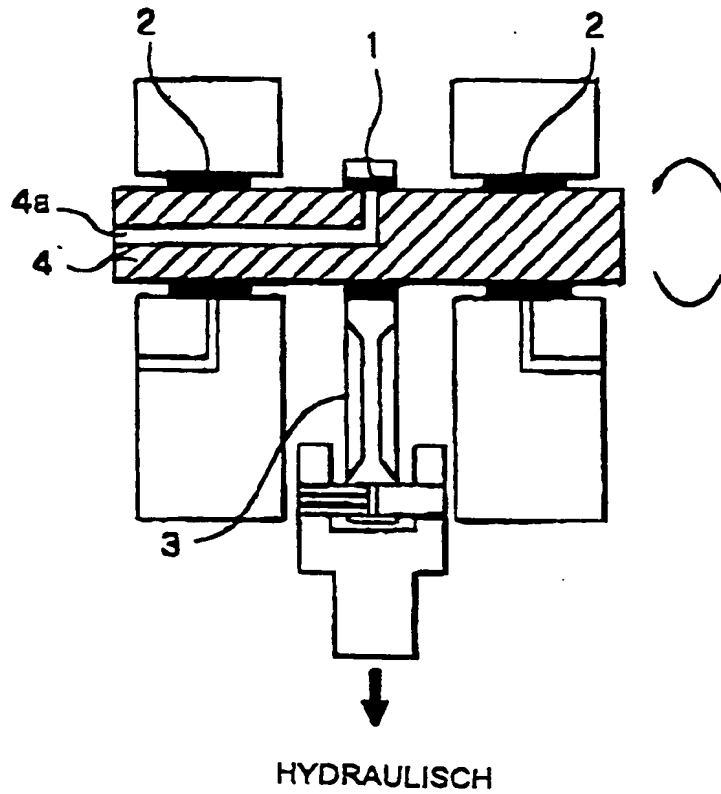


Fig. 2

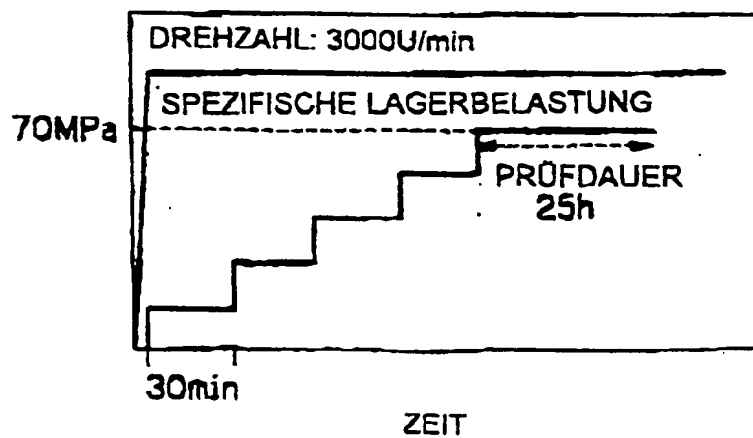
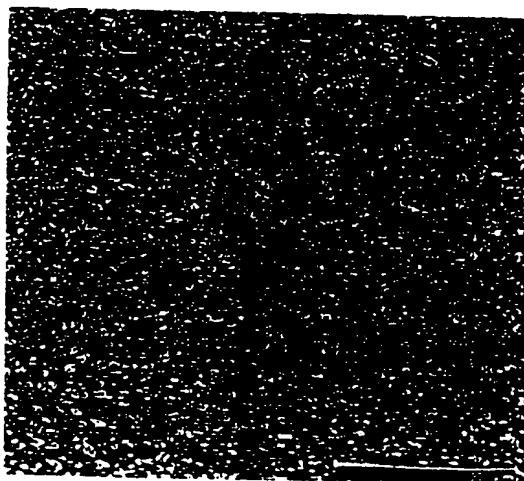


Fig. 3



2.8 μm

Fig. 4

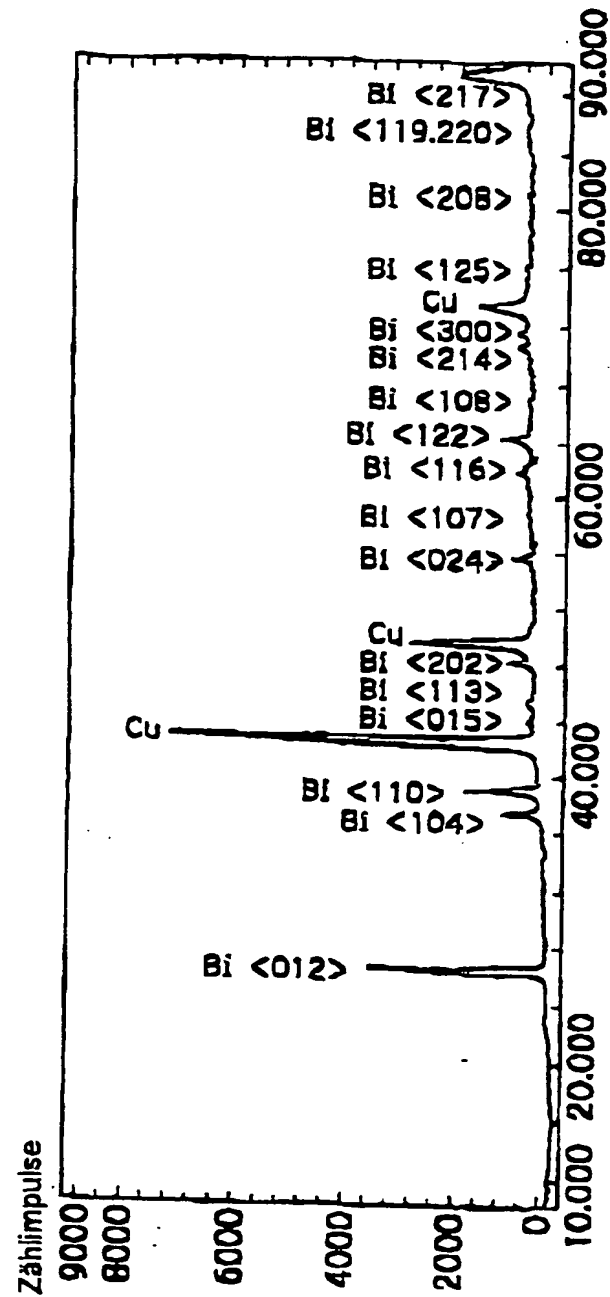
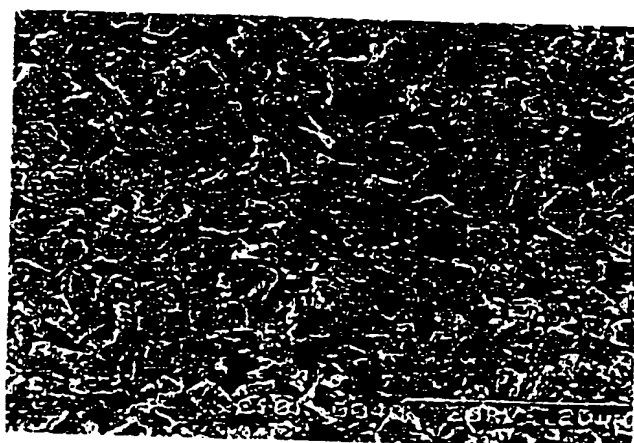


Fig. 5



5.8 μm

Fig. 6

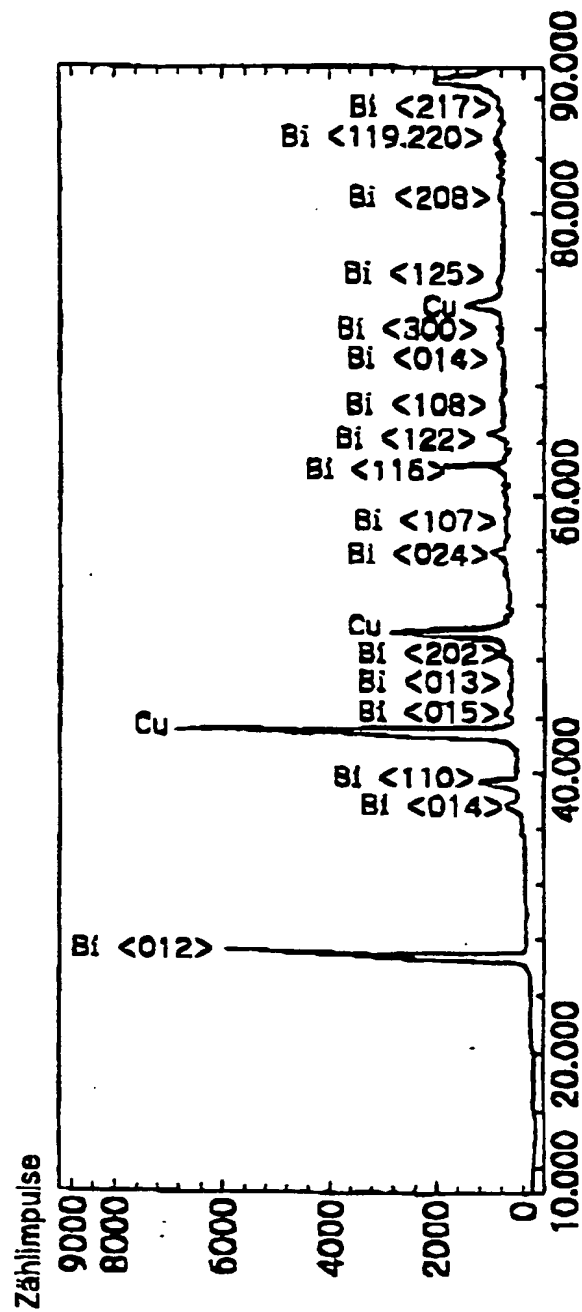


Fig. 7



10.6 μ m

Fig. 8

